有機伝導体における光誘起相転移 東北大理、CREST 岩井 伸一郎





ii) 二次元BEDT-TTF塩の光誘起絶縁体-金属転移 超高速ダイナミクスと相転移の機構
iii) 光誘起"金属"とはなにか? THz 分光による探索
iv)まとめと今後の展開



Photo-induced I-M transition in correlated electron system

Melting of "frozen electron" (Mott insulator, Charge order)







insulator

metal

organic salts (molecular solids)



•3d transition metal compounds
 (Oxides and complexes)
 U,V (5-10 eV)>>t (1 eV)

Fiebig, APB71, 211(2000). Ogasawara. PRB63, 113105(2001) Cavalleri, PRL87, 237401(2001). Iwai, PRL91, 057401(2003). Perfetti, PRL97, 067402(2005). Polli, Nature Mat. 6, 643(2007). etc....

• Organic salts U, V (0.5-1 eV) >> t(0.1 eV)

Chollet, Science 307, 86 (2005). Okamoto, PRL 98, 037401(2007) Iwai, PRL98, 097402(2007). Onda, PRL101,067403(2008).

- intermol. & intramol. motion
- detectable dynamics
 1/t~40 fs, vibration ~10 fs

Electronic /optical functions in highly correlated organic salts





Photo-induced I-M transition

- Tajima et. al. JPSJ 74, 511(2005)
- Chollet, Koshihara et al.
 Science 307, 86(2005)
- Iwai et al.
 PRL98, 097402(2007).

2-D Organic conductor: BEDT-TTF based salts (3/4filling)



Various electronic state

Charge Order(CO)

- Mott insulator
- Superconductor
- Ferroelectricity

Seo, et al. Chem. Rev. 104, 5005(2004). Seo et al. JPSJ75, 051009(2006)

Mori et al. PRB57, 12023(1998). Takahashi, et al. JPSJ75,051008(2006). Miyagawa et al. PRB62, R7679(2000). Takano et al. J. Chem. Phys. Solids 62, 393(2001)

ET₂Xの光誘起相転移

Iwai et al. PRL98, 097402(2007). Yamamoto et al. Iwai et al. PRB77, 125131(2008). JPSJ77, 74709(2008)





ET塩の光誘起相転移





(a) α-(ET)₂I₃



(b) θ -(ET)₂RbZn(SCN)₄



・立ち上がり< 100 fs ・減衰 0.1 ps, 2 ps

・立ち上がり< 30 fs ・臨界緩和

⇔1/tの時間スケール:40 fs



電子応答



(c) κ -(d-ET)₂Cu[N(CN)₂]Br



・立ち上がり1ps

格子が関与

PIMT in charge ordered ET salt (MIR100 fs, NIR30 fs)



:photo-carrier doping +intramolecular motion? microscopic ~10 nm scale







Condensation intermol. distortion 0.1-1 ps



 α -(ET)₂I₃

Libration:<100cm⁻¹ CO 48 cm⁻¹ metallic 38 cm⁻¹ (coherent phonon)



ダイマーモット型有機伝導体 *к*-(ET)₂Xにおける光誘起絶縁体 - 金属転移



Kawakami, Iwai et al. PRL accepted (2009)

ダイマーモット型有機伝導体 *к*-(ET)₂X



tではなくて、 U_{dim} を変える!

d-Br→metal △*U*~0.5%
 格子変位(伸縮振動) ~0.05 %

 d-Cl→metal △*U*~9%
 ~0.5 %

過渡反射スペクトル(*d*-Br,*d*-Cl,Cu₂(CN)₃)



反射率変化の時間発展(d-Br,d-Cl, Cu₂(CN)₃)



κ-(ET)₂Xにおける光応答のバンド幅依存性



コヒーレントフォノン(d-Br, d-Cl, Cu₂(CN)₃)



27cm⁻¹の振動構造の起源





ダイマー内励起とダイマー間(ハバードギャップ)励起



ET₂Xの光誘起絶縁体一金属転移 まとめ

PRL98, 097402(2007), PRB77, 125131(2008), JPSJ77, 74709(2008)

光キャリアドープ(動的な価数制御)



(a) α -(ET)₂I₃

微視的ドメイン

→超高速緩和



(b) θ -(ET)₂RbZn(SCN)₄

巨視的ドメインの生成

(電子-格子相互作用)

PRL to be published (2009)



(c) κ -(d-ET)₂Cu[N(CN)₂]Br

ダイマー内励起; U_{dimer}の変調 (バンド幅制御)

ダイマー間励起; 光キャリアドープ (価数制御)

分子配列に応じたメカニズム

Slower dynamics of Photo-induced metallic state



有機伝導体の光誘起相転移

・はじまりのはじまりは? 電子分極 → ? → 低周波格子振動 分子内振動?

< 10 fs 分光

・なにができているのか? 温度転移、元素置換などによる物質相との 類似性、違い?

THz 分光

・低波数素励起の共鳴励起による相転移 格子振動、ドメイン壁振動......

THz 光による共鳴励起

(*θ*-RbZn)



分子内振動; 価数の変化をプローブ



電子 - 格子相互作用



κ-(ET)₂X におけるEMV結合と絶縁体 - 金属転移



光誘起"金属"とは、どんな状態なのか?



Dressel et al. J. Phys. I France 4, 579(1994).

DC伝導度 30-50/(Ωcm) ~ 光学伝導度 (1cm⁻¹) ドルーデ的ではない?

α-(ET)₂I₃の高温("金属")相



AA'の不均化は融解 BCは、不均化

Kakiuchi, Sawa et al. JPSJ76, 113702(2007)



テラヘルツ過渡吸収分光装置



1) 定常測定(温度転移)

i) TDS(定常分光)による伝導度、誘電率の温度依存性

ii) 高温相("金属相")の電子状態の考察

2) 過渡測定(光誘起絶縁体一金属転移) i) これまでの結果(中赤外ポンププローブ分光)

ii) 近赤外励起-THzプローブ分光(THz過渡吸収分光)

- ・励起強度依存性と温度依存性
- 多層膜モデルによる過渡スペクトルの解析

・光誘起金属状態と高温相の比較



THz

デバイ型緩和モデル(過減衰プラズマ応答)



•130 K<T<Tc:デバイ型緩和

- 高温相:デバイ型緩和+低エネルギーweight
- • T_c におけるフォノン消滅 \rightarrow 静電遮蔽効果

1) 定常測定(温度転移)

i) TDS(定常分光)による伝導度、誘電率の温度依存性の観測

(•T_c近傍での転移の前駆現象、T_cで格子振動の遮蔽)

ii) 高温相("金属相")の電子状態の考察

・デバイ型緩和モデル+低エネルギー重率

2) 過渡測定(光誘起絶縁体一金属転移)

i) これまでの結果 (中赤外ポンププローブ分光)

ii) 近赤外励起-THzプローブ分光(THz過渡吸収分光)

- ・励起強度依存性と温度依存性
- ・多層膜モデルによる過渡スペクトルの解析

光誘起金属状態と高温相の比較



THz



→ 励起光(近赤外)とプローブ光(THz)の進入長の違い?

多層膜モデル



光誘起金属状態



20 K ・高温相の金属状態と類似 (過減衰のプラズマ応答)

124 K

・高温相の金属状態と異なる <5meVに大きなスペクトル重率 → よりドルーデに近い金属が生成??

光誘起金属状態

0.3





臨界減速



まとめ

近赤外励起-THzプローブ分光によるα-(ET)₂I₃の光誘起相転移の i) 定常測定(THz時間領域分光)

温度転移(電荷秩序-金属)にとな THzスペクトルの変化を測定
 金属相;デバイ型緩和モデルによ て (過減衰応答)

- ii) 過渡測定(近赤外励起-THzプローブ分光)
 - ・光誘起金属状態の過渡吸収を観測
 - ・温度、励起強度に依存したスペクトル形状の変化

20 K(*T*<<*T*_c) ・ブロードなスペクトル()

高温相の金属状態()に類似の状態
 (AA'は融解、BCは不均化?)

- 124 K(*T*~*T*_c) ・低エネルギー (<5 meV)にスペクトル重率 (長 , 強励起の)
 - ・光誘起金属状態は、高温相とは異なる状態 (AA' BC 融解?)

まとめ 二次元有機伝導体(BEDT-TTF)₂Xの光誘起相転移

- i) 光誘起絶縁体-金属転移の機構
 - ・光による価数制御
 - ・光による有効バンド幅(U or t)制御
 - ・励起エネルギーによ て機構を
- ii) 光誘起金属状態のテラヘルツ応答
 - 平衡相とは異なる"金属状態"

iii) 絶縁体ー金属ドメイン壁の振動

今後の展開

- ・近赤外~中赤外 時間分解 の 上
- ・THzプローブ光の 域化 (> 10 THz)→中赤外と
- ・高強度THzによる相転移 (バンド幅制御→超伝導?)